

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 6 部門第 2 区分
 【発行日】平成28年8月25日 (2016.8.25)

【公開番号】特開2015-75720(P2015-75720A)
 【公開日】平成27年4月20日 (2015.4.20)
 【年通号数】公開・登録公報2015-026
 【出願番号】特願2013-213467(P2013-213467)
 【国際特許分類】

G 0 2 F 1/1368 (2006.01)

G 0 9 F 9/30 (2006.01)

【 F I 】

G 0 2 F 1/1368

G 0 9 F 9/30 3 3 8

【手続補正書】
 【提出日】平成28年7月11日 (2016.7.11)
 【手続補正 1】
 【補正対象書類名】特許請求の範囲
 【補正対象項目名】全文
 【補正方法】変更
 【補正の内容】
 【特許請求の範囲】
 【請求項 1】

基板と絶縁膜との間に設けられた走査線と、

表示領域において、前記絶縁膜の前記走査線とは反対側に設けられた第 1 トランジスター、および該第 1 トランジスターに電氣的接続された第 1 画素電極を備えた第 1 画素と、
 前記表示領域と隣り合う領域において、前記絶縁膜の前記走査線とは反対側に設けられた第 2 トランジスター、該第 2 トランジスターに電氣的接続された第 2 画素電極を備えた第 2 画素と、

を有し、

前記第 1 トランジスターは、前記絶縁膜に形成された第 1 コンタクトホールを介して導通する第 1 ゲート電極を備え、

前記第 2 トランジスターは、前記絶縁膜に形成された第 2 コンタクトホールを介して導通する第 2 ゲート電極を備え、

第 1 コンタクトホールおよび第 2 コンタクトホールは、平面サイズが異なることを特徴とする電気光学装置。

【請求項 2】

前記第 1 画素は表示画素を構成し、前記第 2 画素は前記基板と前記絶縁膜との間で前記第 2 画素電極と重なる遮光層を備えたダミー画素を構成し、

前記走査線が延在する第 1 方向および前記走査線の延在方向と交差する第 2 向のうちの少なくとも一方において、前記第 2 コンタクトホールの端部と前記走査線の端部との間隔が、前記第 1 コンタクトホールの端部と前記走査線の端部との間隔より広いことを特徴とする請求項 1 に記載の電気光学装置。

【請求項 3】

前記第 1 コンタクトホールおよび前記第 2 コンタクトホールは、前記第 1 方向の寸法と、前記第 2 方向の寸法とが相違しており、

前記第 1 方向および前記第 2 方向のうち、前記寸法が大の方向において、前記第 2 コンタクトホールの端部と前記走査線の端部との間隔が、前記第 1 コンタクトホールの端部と前記走査線の端部との間隔より広いことを特徴とする請求項 2 に記載の電気光学装置。

【請求項 4】

前記第 2 方向において、前記第 2 コンタクトホールと前記走査線の端部との間隔が、前記第 1 コンタクトホールと前記走査線の端部との間隔より広いことを特徴とする請求項 2 または 3 に記載の電気光学装置。

【請求項 5】

前記第 2 コンタクトホールと前記走査線の端部との間隔が、前記第 1 コンタクトホールと前記走査線の端部との間隔の 1.10 倍以上、 1.50 倍以下であることを特徴とする請求項 2 乃至 4 の何れか一項に記載の電気光学装置。

【請求項 6】

前記第 1 ゲート電極および前記第 2 ゲート電極は、平面サイズが等しく、

前記第 2 コンタクトホールの平面サイズが、前記第 1 コンタクトホールの平面サイズより小であることを特徴とする請求項 1 乃至 5 の何れか一項に記載の電気光学装置。

【請求項 7】

前記第 1 コンタクトホールは、前記第 1 トランジスターの半導体層を挟む両側 2 個所に設けられ、

前記第 2 コンタクトホールは、前記第 2 トランジスターの半導体層を挟む両側 2 個所に設けられていることを特徴とする請求項 1 乃至 6 の何れか一項に記載の電気光学装置。

【請求項 8】

前記走査線と前記遮光層とは同一の遮光膜からなることを特徴とする請求項 2 乃至 7 の何れか一項に記載の電気光学装置。

【請求項 9】

請求項 1 乃至 8 の何れか一項に記載の電気光学装置を備えていることを特徴とする電子機器。